
	<h2>SIR403EDP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR403EDP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 40A PPAK 8SO</p> <p>Datenblätter:  SIR403EDP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23106 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR403EDP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 40A PPAK 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23106 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 40A (Tc) 5W (Ta), 56.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 56.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	153nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4620pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIR403EDP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR403EDP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR403EDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR403EDP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR402DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR402DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR406DP SI SIR406DP SI</p>	 <p>SIR403EDP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 40A PPAK 8SO</p>
 <p>SIR404DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR404DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR404DP VB SIR404DP VB</p>	 <p>SIR404DP-T1-E3 VISHAY SIR404DP-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SIR158DP-T1-GE3	↔ SIR158DP-T1-GE3	⇒ SIR164ADP-T1-GE3	D SIR164DP	⇒ SIR164DP-T1-E3
⊕ SIR164DP-T1-GE3	⊕ SIR164DP-T1-GE3	D SIR166DP	⇒ SIR166DP-T1-E3	⇒ SIR166DP-T1-GE3
⊕ SIR166DP-T1-GE3	⊕ SIR168DP	⊕ SIR168DP-T1-GE3	↔ SIR168DP-T1-GE3	⇒ SIR172ADP-T1-GE3
D SIR172ADP-T1-GE3	⊕ SIR172DP	⊕ SIR172DP-T1-E3	⊕ SIR172DP-T1-GE3	⇒ SIR172DP-T1-GE3
⇒ SIR330DP-T1-GE3	↔ SIR330DP-T1-GE3	⊕ SIR402DP-T1-GE3	⊕ SIR402DP-T1-GE3	⇒ SIR403EDP-T1-GE3
↔ SIR404DP	⇒ SIR404DP-T1-E3	D SIR404DP-T1-GE3	⊕ SIR404DP-T1-GE3	⊕ SIR406DP
⊕ SIR406DP-T1-E3	D SIR406DP-T1-GE3	⇒ SIR406DP-T1-GE3	↔ SIR406DP-T1-GE3-S	⇒ SIR408DP-T1-GE3
⊕ SIR408DP-T1-GE3	⊕ SIR410DP-T1-E3	↔ SIR410DP-T1-GE3	⇒ SIR410DP-T1-GE3	⇒ SIR412DP
⊕ SIR412DP-T1-E3	⊕ SIR412DP-T1-GE3	⊕ SIR412DP-T1-GE3	D SIR414DP	⇒ SIR414DP-T1-GE3
↔ SIR414DP-T1-GE3	⊕ SIR416DP	⊕ SIR416DP-T1-E3	⊕ SIR416DP-T1-GE3	⇒ SIR416DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited